

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2015 年 4 月 2 日(02.04.2015)



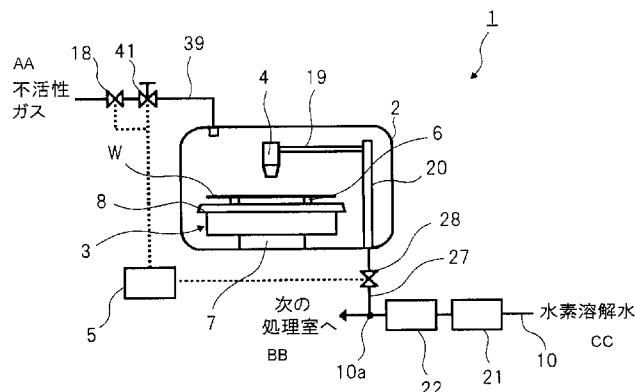
(10) 国際公開番号
WO 2015/045975 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/074481 (74) 代理人: 宮崎 昭夫, 外(MIYAZAKI, Teruo et al.);
〒1050001 東京都港区虎ノ門 2 丁目 1 〇 番 1 号
虎ノ門ツインビルディング西棟 1 1 階 Tokyo (JP).
- (22) 国際出願日: 2014 年 9 月 17 日(17.09.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語 (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (30) 優先権データ:
特願 2013-198535 2013 年 9 月 25 日(25.09.2013) JP
特願 2013-198549 2013 年 9 月 25 日(25.09.2013) JP
特願 2013-206447 2013 年 10 月 1 日(01.10.2013) JP
特願 2014-097459 2014 年 5 月 9 日(09.05.2014) JP
- (71) 出願人: オルガノ株式会社(ORGANO CORPORATION) [JP/JP]; 〒1368631 東京都江東区新砂 1 丁目 2 番 8 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 矢野 大作(YANO, Daisaku); 〒1368631 東京都江東区新砂 1 丁目 2 番 8 号オルガノ株式会社内 Tokyo (JP). 山下 幸福(YAMASHITA, Yukinari); 〒1368631 東京都江東区新砂 1 丁目 2 番 8 号オルガノ株式会社内 Tokyo (JP). 村山 雅美(MURAYAMA, Masami); 〒1368631 東京都江東区新砂 1 丁目 2 番 8 号オルガノ株式会社内 Tokyo (JP). 山中 弘次(YAMANAKA, Koji); 〒1368631 東
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR),

[続葉有]

(54) Title: SUBSTRATE TREATMENT METHOD AND SUBSTRATE TREATMENT DEVICE

(54) 発明の名称: 基板処理方法および基板処理装置



AA Inert gas
BB To next treatment chamber
CC Hydrogen-dissolved water

(57) Abstract: Provided are a substrate treatment method and a substrate treatment device enabling greater suppression of corrosion or oxidation of metal wiring exposed on a substrate surface. The present invention relates to a substrate treatment device (1) having a treatment chamber (2) wherein a substrate (W) is disposed, and whereto a substrate treatment solution for treating the substrate (W) is supplied. This device is provided with an inert gas filling mechanism (18, 39, 41) for filling with an inert gas the interior of the treatment chamber (2) wherein the substrate (W) is disposed, and, near or inside the treatment chamber (2), a catalytic unit (21) filled with a platinum-group metal catalyst wherethrough a hydrogen-dissolved water comprising hydrogen added to ultra-pure water is passed. Obtained by passing the hydrogen-dissolved water through the platinum-group metal catalyst, a hydrogen-dissolved treatment solution is supplied as the substrate treatment solution into the treatment chamber (2) by the device.

(57) 要約:

[続葉有]



WO 2015/045975 A1



OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

基板表面に露出した金属配線の腐食や酸化を、より一層抑制できる、基板処理方法及び基板処理装置を提供する。本発明は、基板 (W) が配置され、基板 W を処理する基板処理液が供給される処理室 (2) を有する基板処理装置 (1) に係る。この装置は、基板 W が配置された処理室 (2) の中に不活性ガスを充填する不活性ガス充填機構 (18, 39, 41) と、処理室 (2) の近傍または内部に超純水に水素を添加してなる水素溶解水を通液する白金族系金属触媒が充填された触媒ユニット (21) と、を備え、該水素溶解水を白金族系金属触媒に通液して得た水素溶解処理液を前記基板処理液として処理室 (2) 内に供給するものである。